TALK ABOUT

究所 細 備造 新ステー ショ ン総合研究官 板東義雄

版東 義雄 先生のご紹介

 1975年
 大阪大学大学院理学研究科博士課程終了 科学技術庁無機材質研究所入所

 1979年から2年間米国アリゾナ州立大学留学

 1996年
 同研究所超微細構造解析ステーション総合研究官

 1993年
 筑波大学連携大学院物質工学教授を併任

 ご専門
 電子顕微鏡によるセラミックス材料の構造解析

 受賞
 日本電子顕微鏡によるセラミックス材料の構造解析

 科学技術庁長官賞
 科学技術庁長官賞

1 はじめに

電子顕微鏡 (TEM)は 1932年にド イツのルスカ (1986年度 のノーベル物 理学賞)によ



り世界で最初に開発されて以来,約半 世紀をへた今日,分解能は飛躍的に向 上し、原子の配列を1個1個観察する ことができるようになっています。例 えば,最新の高分解能電子顕微鏡(加 速電圧200KV)の分解能は約0.2nm を切り、ほぼ装置の極限の分解能値に まで到達しています。また,TEM本体 に分析付属装置を組み込んだいわゆる 分析電子顕微鏡も広く普及し,原子の 配列の観察機能に加えて,組成や電子 状態の測定もまた可能となっていま す。とりわけ近年になり,高輝度な電子 ビーム発生源として電界放射型電子銃 を搭載した電子顕微鏡も開発され,高 電流の電子ビームを約1nm径以下にま で細く収束し,ビーム径程度の極微な 領域での元素分析や構造解析ができる ようになっています。ますます完成度 を高めた最近の電子顕微鏡は セラミッ クス、金属、半導体、有機材料など様々 な材料開発研究にとり必要不可欠な装 置として幅広く利用されています1)~6)。

ここでは,電子顕微鏡の最近の技術 的な進歩として電界放射型電子顕微鏡 の開発とその特徴を紹介,また新材料 探索研究のホットな話題として,我々 のグループで進めているB-C-N系の新 規なフラーレンの研究成果について紹 介します。

2 電子顕微鏡の最近の進歩

2.1 300KV電界放射型電子顕微鏡の開発と主な特徴

電界放射型電子銃 (FEG)はタング

ステンの針の先端に強い電場をかけ て,電子を強引に引き出す方式で,ホ ウ化ランタン (LaB_x) エミッターを用 いた従来型の熱電子放射銃に比べて, 1)約1,000倍以上高輝度である, 2)入射電子ビームのエネルギー分布 が小さく、そのため電子線の干渉性が 高い,などの優れた利点をもっていま す。しかし, FEGをTEMの鏡体に搭 載するには約10⁻⁸Pa程度の超高真空 を要するため、これまでTEMの電子銃 として利用することが困難でした。し かし,1990年代に入るとTEMの超高 真空技術の急速な進展により,汎用型 のTEMの電子銃としてFEGが積極的 に利用されるようになってきました。 無機材質研究所は最近,日本電子と共 同で加速電圧300KVの電界放射型電 子顕微鏡 (JEM-3000F) を開発しま した7)8)。

本装置は高分解能観察機能と分析機 能を可能な限り高めようと意図して開 発したもので,現在世界最高レベルの 性能を持っています。電子ビームを最 小で径約0.4nm以下にまで絞り込むこ とができ,その際の電子ビーム強度を 約0.1nA(ナノアンペア)と言った大 電流を流すことができます。また,X線 の取り出し角度も0.2ステラジアン (str)と大きく,微弱なX線信号を高感 度に検出できるように設計されていま す。さらに,パラレル検出型の電子エ ネルギーアナライザーも取り付けられ, 軽元素の分析を高精度に行なえます。

本装置は原子の配列を直視しなが ら,ビーム径程度の極微な領域の元素 分析を同時測定することができる優れ た観察機能を持っています。以下に, その実例を紹介します。

2.2 サブナノ領域レベルの構造解析 1)窒化アルミニウム(AIN)の多形 の構造



図1 AIN多形(9AIN・AI₂O₃)の格子像(a)と対応したAI-O層(b). AI-N層(c)からの特性X線スペクトル。単原子層レベルの元素分析を 実現。

AINは高熱伝導性の電子材料として 注目され,アルミナに代わるLSI基板 としての用途が期待されています。不 純物の酸素が固溶すると,多形と呼ば れる長周期構造が出現します。その時, 窒素の一部を置換した酸素がどのよう に分布しているのか未だ良く分かって いません。

図1(a)は9AIN・Al_aO_a(六方晶, 格子定数a=0.32nm, c=8.6nm)の 格子像です。金属であるAI原子が黒い 点として明瞭に観察されていますが, 酸素や窒素の軽い原子は像には直接に は反映されていません。従って,格子 像からは軽元素がどこに位置している のかは判定できないわけです。(b)と (c) は径約0.5nmの電子ビームを試 料の一点に照射(約30秒間)し,観 測した特性X線(EDS)スペクトルで す。(b) は格子像中のAI-Oと記された 原子層の領域から、(c)はAI-N層の領 域から観測した特性X線です。(b)で はAIの特性X線の他に酸素のX線も観 測され,窒素はほとんど検出されてい

ません。一方、(c) ではAIと窒素のX線 が同時に観測されて います。もし,酸素

が窒素の一部を統計的に置換している なら(b)と(c)のスペクトルは同じ ように観測されるはずです。しかし, 実際はそうでなく,酸素原子が特定の 原子列に局在化して配位していること がわかります[®]。

2)ダイヤモンド状BC,Nの構造

炭素(C)と窒化ホウ素(BN)は構 造や性質が非常に似ていることから, 両者の間に固溶体が生成すると考えら れています。低圧相(グラファイト状) の場合,乱層構造をもつBC₂Nが存在 する事が知られています。一方,高圧 相については最近無機材質研究所の 中野らが低圧相のBC₂Nをベルト型高 圧装置を用いて,7.7GPaの高圧, 2300°Cの高温で,約15分間処理し, 高圧相のBC₂Nの合成を試みましたが, その構造を正確に評価するまでには至



図2 ダイヤモンド状BC₂Nの格子像とその計算像(図中に挿入) (a)とその電子エネルギー損失(EELS)スペクトル(b)、新物 質はダイヤモンド型の原子構造をし,化学組成はBC₂Nであるこ とが判明。

りませんでした。)。

図2(a)はダイヤモンド状BC₂Nの 格子像です。格子像にみられる黒い点 の配列はダイヤモンド構造を示唆する ものです。

図2(b)は格子像を観察したもの と同じ試料領域に径約1nmの電子ビ ームを照射して観測した電子エネルギ ー損失(EELS)スペクトルです。B, C,Nの3元素が明瞭に観察されてい ます。特に,ダイヤモンド型構造に特 有の *ピークと呼ばれる微細なピー クが現れています。スペクトルの定量 分析を行うと,組成はおおよそBC₂N (測定誤差は約20%以内)と求められ ました。このように,格子像観察と EELS測定を併用することにより,ダ イヤモンド構造を持つ高圧相BC₂Nの 構造を世界で最初に解析することに成 功しました¹⁰⁾¹¹。

TALK ABOUT



図3 電子線照射による方法で作製したBC₂Nフラーレン(a)とBNフ ラーレン(b) BC₂Nフラーレンでは玉ねぎ状の形をした球状の微粒子 (直径は約3nm,コア大きさは約0.7nmで5層のグラファイト面)。BN フラーレンでは四角いサイコロ状の微粒子(左が約3.2nmで5層のグラ ファイト面,右が約2.5nmで4層のグラファイト面,コアの大きさは共 に0.3~0.4nm)。

3 新規なフラーレンの発見

カーボン(炭素)のフラーレンは 1985年に英国サセックス大のクロ トーらにより発見され,世界的に大き な反響を呼びました(1996年度のノ ーベル化学賞)。フラーレンは化学式 「C60」で代表され,炭素原子が60個 集まって,サッカーボールの形をして おり,世界で多数の研究者がこの分野 の研究を行っています。しかしながら, 炭素以外の元素からなる新規なフラー レンは今日まで発見されませんでし た。我々は,B-C-N系において,新規な フラーレンが存在するのではないかと の予測のもとその合成を試みました。

B-C-N系においては炭素と同様のグ ラファイト構造を持つ物質として,窒 化ホウ素(BN),炭窒化ホウ素 (BC₂N)や炭化ホウ素(BC₃)などが 知られています。これらの層状物質は, 炭素に比べて耐熱性,強度や化学的な 安定性などに優れており,もしカーボ ンと同様のフラーレンができれば,触 媒や半導体としての新規な特性の発現 が期待されます。

3.1 電子ビーム照射によるフラーレン創製

出発試料はBN やBC₂Nの薄膜で, グラファイトと同 じ六方晶の層状構 造をしていますが, 諸晶が互いに乱れて 間層した乱配層構造 とでをビームの径を 試料により約1nm そ により約10nm程度 30分間程度試料表

面付近を集中的に照射しました。照射 する際の電子ビームの強度は単位平方 センチメートル当たり約100アンペア と,通常の電子顕微鏡観察の約100倍 の大電流を用いました。集中的な電子 ビームの照射により,結晶表面近傍の グラファイト状の網目が1層から数層 の範囲で剥離し,それらが徐々に丸み をおびていき,ついには玉ねぎ状の形 をした微粒子(オニオンと呼ばれてい ます)が生成します。これがフラーレ ン粒子です。

図3はこのようにして作製した BC₂Nフラーレン¹³⁾(a)とBNフラー レン¹⁴⁾(b)です。BC₂Nフラーレン粒 子の直径は約3nmで,球状の形をし, 5層のグラファイト層面が玉ねぎ状に 巻きあがってできています。一方, BNフラーレンは球形ではなく,サイ コロ状の四角い形をしています。左の 大きい粒子(約3.2nm)は5層のグラ ファイト層面が,右の小さい粒子(約 2.5nm)で4層のグラファイト層面が 巻きあがってできています。両者の形 態はBC₂Nフラーレンが球状,BNフラ ーレンがサイコロ状と大きく異なって いる点が注目されます。

3.2 新規フラーレンの構造

グラファイト構造を持つ炭素原子は 図4(a)のように6員環状に配置して います。この1枚のグラファイト層面 が球状に閉じるには,6員環(ヘキサ ゴン)の一部に欠陥が生じ,5員環 (ペンタゴン)が生成する必要があり ます。すなわち,12個のペンタゴン と20個のヘキサゴンが(b)の様に配 置することにより,サッカーボールの 形をしたC60の構造が出来上がります。

 一方, B-C-N系の多元素物質においては, B-BやN-Nと言った同種元素同 士の結合はエネルギー的に不安定で起こりにくいと考えられています。従って, BC₂N, BNなどの新規フラーレンの構造はC₆₀の場合とは大きく異なることが予想されます。

図4(c)にBC₂Nフラーレンの構造モ デルを示します。図3(a)で観察され たBC₂Nフラーレン粒子のコアの大き さ(1層)は約0.7nmです。この大き さはC60のそれ同じです。従って,



図4 グラファイトの構造を持つ炭素原子の配列(6員環)(a)とC $_{60}$ フラーレン(b)および $BC_{2}N$ フラーレン(c)の構造モデル。



図5 BNフラーレンの構造モデル。最小分子は $B_{12}N_{12}$ で グラ ファイト層面の数が増えるにつれて $B_{76}N_{76}$ (2層). $B_{208}N_{208}$ (3層). $B_{412}N_{412}$ (4層). $B_{676}N_{676}$ (5層)と分子数が巨大化し てゆきます。これらの分子が入れ子状に詰まってできた玉ねぎ 状のフラーレンが実際に観察される。

 $BC_2NフラーレンはB,C,Nの3元素が$ $60個集まって,<math>B_{15}C_{30}N_{15}$ の分子を構 成していると考えられます。B-BやN-Nの同種同士の結合を除外して,C-C, B-N,C-N,C-Bの結合の組み合わせ を考慮すると,図4(c)のような構造 を導くことができます。すなわち, $BC_2Nフラーレンは12個のペンタゴン$ と20個のヘキサゴンの組み合わせで, C_{50} と非常に似た構造をしていること がわかります。

図5はBNフラーレンの構造モデルで す¹⁵)。BC₂Nでは図4の様にペンタゴ ンの形成が可能ですが,2元素からな るBNではペンタゴンは形成できず,4 員環(スクエアー)のみしか構造欠陥 が起こりません。図3(b)に観察され たフラーレン粒子のコアの大きさは約 0.3~0.4nmで,これはBNフラーレ ンの最小分子のB₁₂N₁₂またはB₁₆N₁₆に 対応します。ここでは,BNフラーレ ンの最小分子をB₁₂N₁₂として構造を考 えていきます。B₁₂N₁₂で は6個のスクエアーと6個 のヘキサゴンから構成さ れます。

一方,図3(b)の観察 された玉ねぎ状のフラー レンはグラファイト面が 2層,3層,4層,5層と 巻き込んで成長しており, それに対応してフラーレ ン分子も巨大化していき ます。図5に示された様 に巨大分子フラーレンは グラファイト層面の数に 対応して, B₁, N₁, (1層), $B_{76}N_{76}$ (2層), $B_{208}N_{208}$ (3層), B₄₁₂N₄₁₂(4層), B₆₇₆N₆₇₆(5層)とグラ ファイト層面の増加につ れて巨大化していきます。 そして,これらのフラー

レン分子が入れ子状になって詰まっ て,玉ねぎ状のフラーレンができあが ります。その結果,BNフラーレンは8 面体型のかご構造をし,その外形は4 角形になります。構造モデルは実際に 観察されたフラーレンの外形とも良く 一致しています。

最近我々は,BxC1-x(x=0.1)で 表される新規フラーレンも同様の方法 を用いて発見し,その構造を解析して います¹⁶⁾¹⁷⁾。

4 まとめ

最近の電子顕微鏡研究の最前線と言うことで,300KVの電界放射型分析 電子顕微鏡の開発とそれを用いた新規 フラーレンの探索研究結果について紹介してきました。

電子顕微鏡は今後もますます新機能 を有した新しい装置の開発が必要で す。特に,特性X線や非弾性散乱電子 を単にEDSやEELSとしてのスペクト ルとして観測するだけでなく それらを 高分解能で画像化するマッピング技術 の開発が不可欠です。とりわけ,EELS を活用したエネルギーフィルター法は 構成素の画像化 に加えて,結合状態 の違いをも画像化することが原理的に 可能です。もし,格子像と同じよう な高い分解能でエネルギーフィルター 像が得られれば,原子種や結合状態を 原子レベルで直視でき,新材料の開発 研究には極めて重要な知見をもたらし ます。我々のグループは2000年3月 までにはこのような究極の機能を有し た電子顕微鏡を開発したいと考えてい ます。

文 献

- 1) Y. Bando : J. Electron Microsc., 38, 81 (1989).
- Y. Bando : Mater. Trans. JIM, 31, 538 (1990).
- 3) 板東義雄:セラミックス,27,1183(1992).
- 4) 板東義雄: ぶんせき, 1993, 809,
- 5) 板東義雄: 材料科学, 31, 205 (1994).
- 6) 板東義雄: ぶんせき, 1996, 690,
- 7) Y. Bando et al. : Jpn. J. Appl. Phys. 32, L1704 (1993).
- 8) Y. Bando et al. : Microbeam Analysis, 3, 279 (1994).
- 9) S. Nakano et al. : Chem. Mater. 6, 2246 (1994).
- 10) Y. Bando et al. : J. European Ceramic Soc., 16, 379 (1996).
- 11) Y. Bando et al. : J. Electron Microsco. 45, 135 (1996).
- 12) H. W. Kroto et al. : Nature, 318, 162 (1985).
- 13) O. Stephan & Y. Bando et al. : Appl. Phys. Lett. 70, 2383 (1997).
- 14) O. Stephan & Y. Bando et al. : Appl. Phys A 67, 107 (1998).
- 15) 板東義雄 : Isotope News, 5, 7 (1998).
- 16) D. Golberg & Y. Bando et al. : Appl.Phys. Lett., 72, 2108 (1998).
- 17) D. Golberg & Y. Bando et al. : J. Carbon (1998)(in press).